

パワー・トランジスタ

2SD762, 2SD762A

2SD762, 2SD762A

シリコン NPN 三重拡散接合形 / Si NPN Triple Diffused Junction

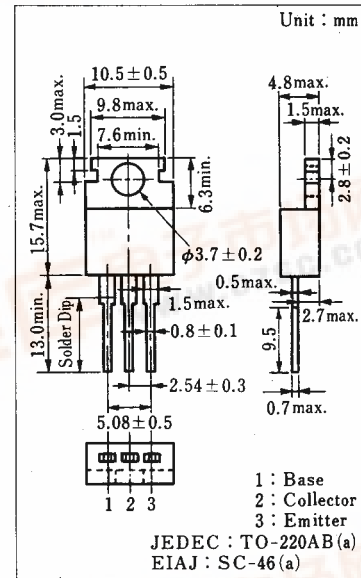
低周波電力増幅用 / AF Power Amplifier

■ 特徴 / Feature

- 安全動作領域 (ASO) が広い。 / Wide area of safe operation (ASO)

■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings (Ta=25 °C)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V _{CB0}	60	V
		80	
コレクタ・エミッタ電圧	V _{CEO}	60	V
		80	
エミッタ・ベース電圧	V _{EB0}	8	V
せん頭コレクタ電流	I _{CP}	6	A
コレクタ電流	I _C	4	A
ベース電流	I _B	1	A
コレクタ損失 (Tc=25 °C)	P _C	30	W
接合部温度	T _j	150	°C
保存温度	T _{stg}	-55 ~ +150	°C



■ 電気的特性 / Electrical Characteristics (Tc=25°C)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタしや断電流	I _{CB0}	V _{CB} =20 V, I _E =0			30	μA
エミッタしや断電流	I _{EB0}	V _{EB} =8 V, I _C =0			1	mA
コレクタ・エミッタ電圧	V _{CEO(sus)} *2	I _C =0.2 A, L=25 mH	60			V
			80			V
直流電流増幅率	h _{FE1}	V _{CE} =3 V, I _C =0.1 A	40			
	h _{FE2} *1	V _{CE} =3 V, I _C =1 A	30		160	
ベース・エミッタ電圧	V _{BE}	V _{CE} =3 V, I _C =1 A			1.2	V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	V _{CE(sat)}	I _C =2 A, I _B =0.4 A			1	V
しや断周波数	f _{ae}	V _{CE} =10 V, I _C =0.2 A		25		kHz

*1h_{FE2}ランク分類 / h_{FE2} Classifications

Class	Q	P	O
h _{FE2}	30~60	50~100	80~160

*2V_{CEO(sus)}測定回路 / V_{CEO(sus)} Test Circuit

